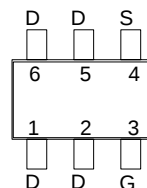
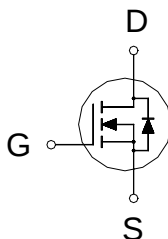


PRODUCT SUMMARY

$V_{(BR)DSS}$	$R_{DS(ON)}$	I_D
30	27m Ω	7A



1. GATE
2. DRAIN
3. SOURCE

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Noted)

PARAMETERS/TEST CONDITIONS		SYMBOL	LIMITS	UNITS
Gate-Source Voltage		V_{GS}	± 20	V
Continuous Drain Current	$T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$	I_D	7	A
	$T_C = 100\text{ }^\circ\text{C}$		5	
Pulsed Drain Current ¹		I_{DM}	20	
Power Dissipation	$T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$	P_D	1.6	W
	$T_C = 100\text{ }^\circ\text{C}$		1.2	
Operating Junction & Storage Temperature Range		T_j, T_{stg}	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Lead Temperature ($1/16$ " from case for 10 sec.)		T_L	275	

THERMAL RESISTANCE RATINGS

THERMAL RESISTANCE	SYMBOL	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$		30	$^\circ\text{C} / \text{W}$
Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$		78	

¹Pulse width limited by maximum junction temperature.

²Duty cycle $\leq 1\%$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Noted)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	LIMITS			UNIT
			MIN	TYP	MAX	
STATIC						
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	30			V
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	1	1.5	3	
Gate-Body Leakage	I_{GSS}	$V_{DS} = 0V, V_{GS} = \pm 20V$			± 100	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS} = 24V, V_{GS} = 0V$			1	μA
		$V_{DS} = 20V, V_{GS} = 0V, T_J = 125^\circ C$			10	
On-State Drain Current ¹	$I_{D(ON)}$	$V_{DS} = 5V, V_{GS} = 10V$	20			A
Drain-Source On-State Resistance ¹	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 5A$		32	40	mΩ
		$V_{GS} = 10V, I_D = 7A$		23	27	
Forward Transconductance ¹	g_{fs}	$V_{DS} = 5V, I_D = 7A$		14.4		S

DYNAMIC						
Input Capacitance	C _{iSS}	V _{GS} = 0V, V _{DS} = 10V, f = 1MHz		680		pF
Output Capacitance	C _{oSS}			140		
Reverse Transfer Capacitance	C _{rSS}			70		
Total Gate Charge ²	Q _g	V _{DS} = 15V, V _{GS} = 10V, I _D = 7A		10	15	nC
Gate-Source Charge ²	Q _{gs}			1.7		
Gate-Drain Charge ²	Q _{gd}			2.1		
Turn-On Delay Time ²	t _{d(on)}	V _{DS} = 10V, I _D ≅ 1A, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = 6 Ω		8.0		nS
Rise Time ²	t _r			4.0		
Turn-Off Delay Time ²	t _{d(off)}			22.0		
Fall Time ²	t _f			5.0		
SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS (T _c = 25 °C)						
Continuous Current	I _S				3	A
Forward Voltage ¹	V _{SD}	I _F = 1A, V _{GS} = 0V			1.1	V

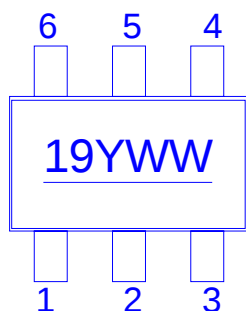
¹Pulse test : Pulse Width $\leq 300 \mu sec$, Duty Cycle $\leq 2\%$.

²Independent of operating temperature.

³Pulse width limited by maximum junction temperature.

REMARK: THE PRODUCT MARKED WITH “19YWW”, DATE CODE or LOT #

Orders for parts with Lead-Free plating can be placed using the PXXXXXXG parts name



Marking Description:

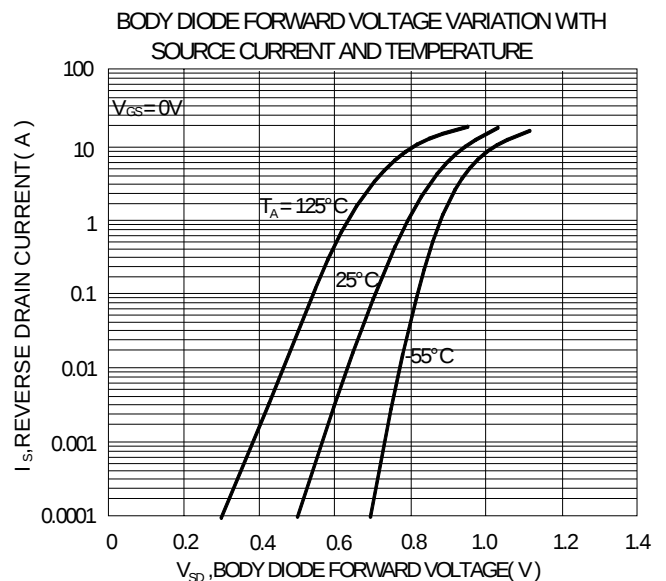
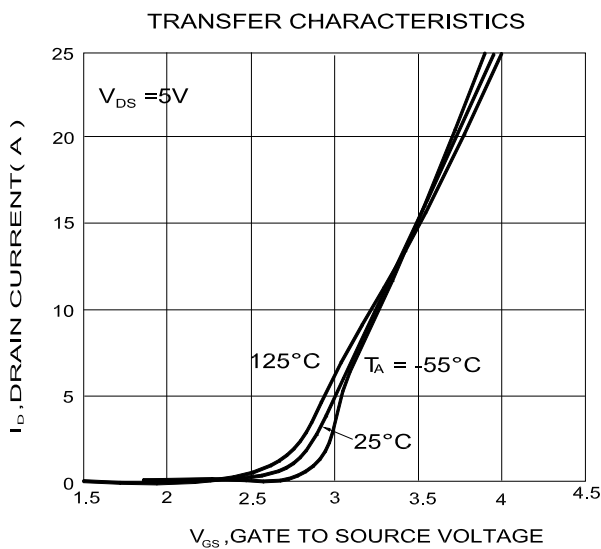
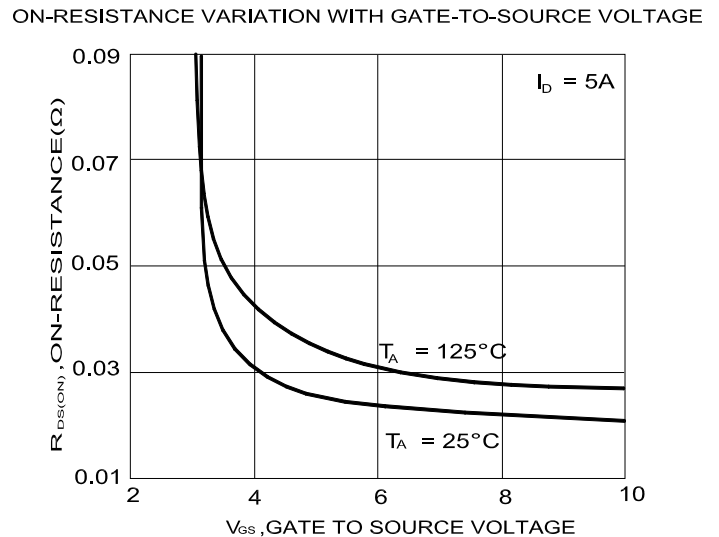
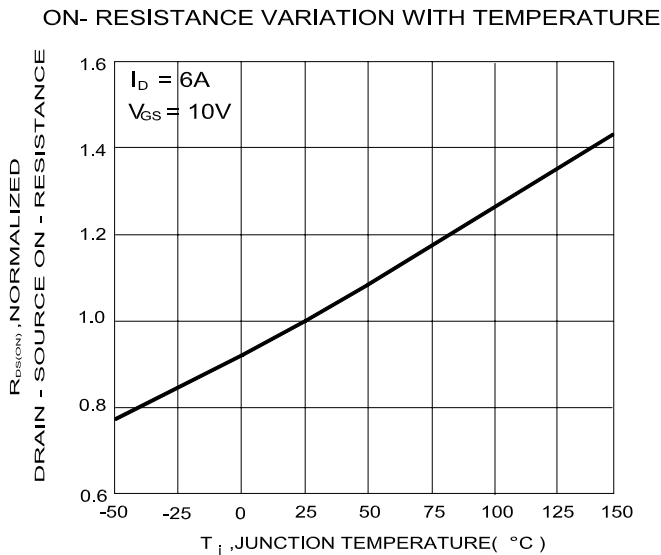
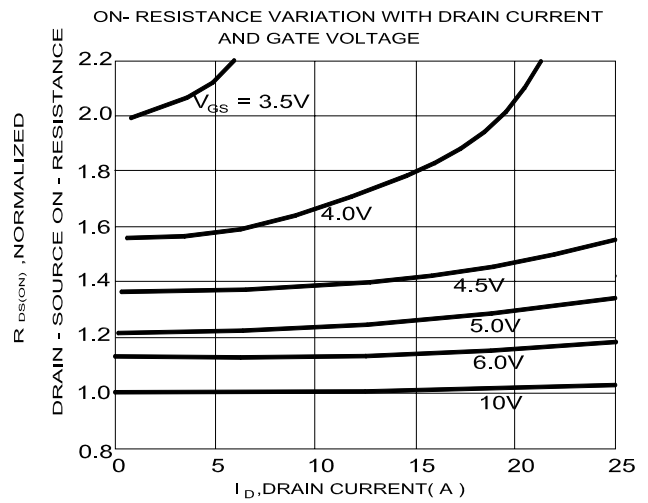
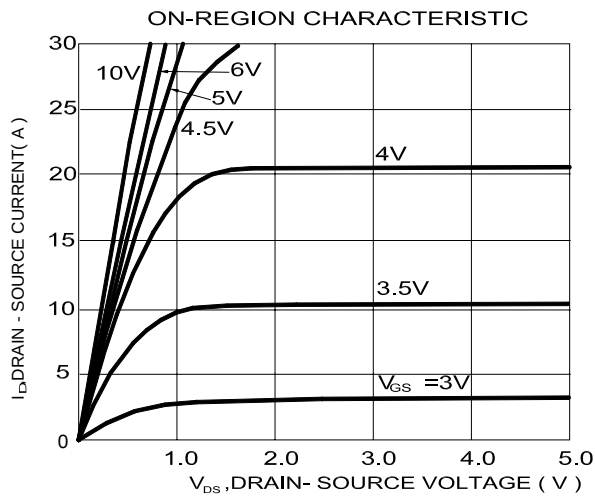
1 - N MOSFET

9 - Serial Number

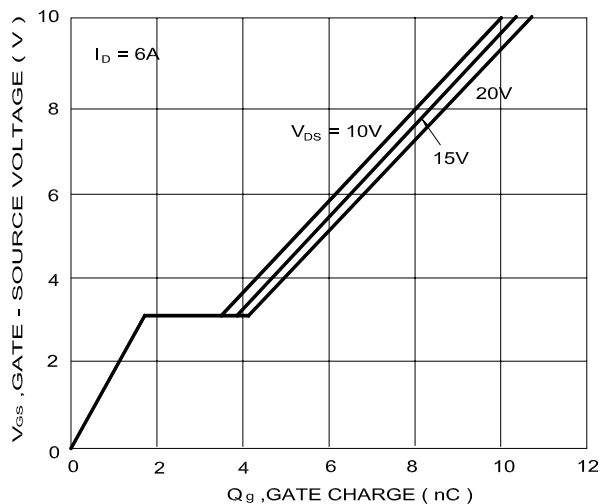
Y - Year

W - Week

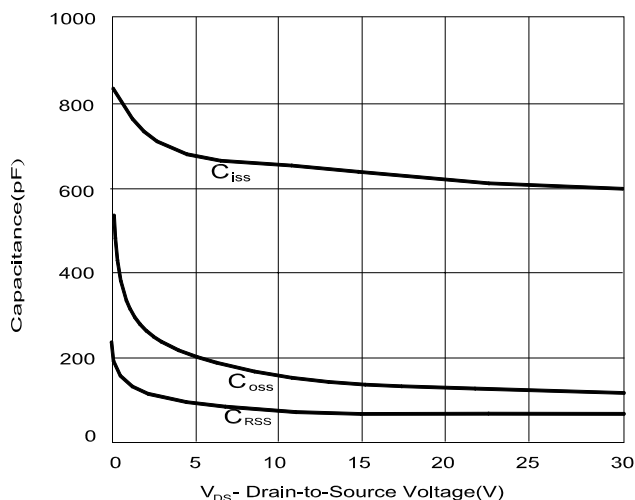
TYPICAL CHARACTERISTICS



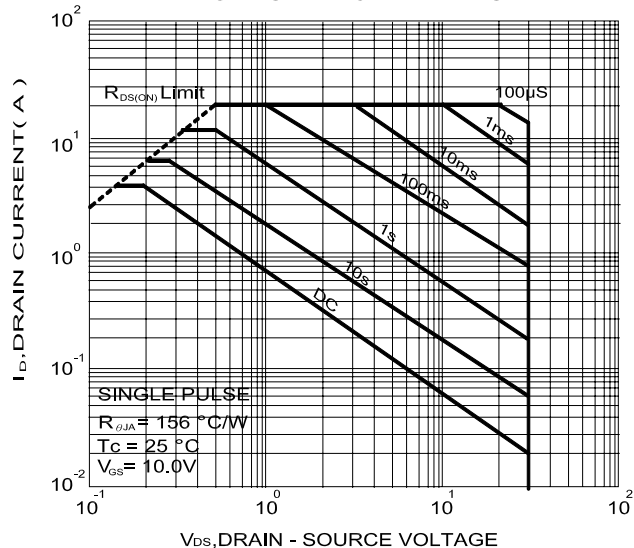
GATE CHARGE CHARACTERISTICS



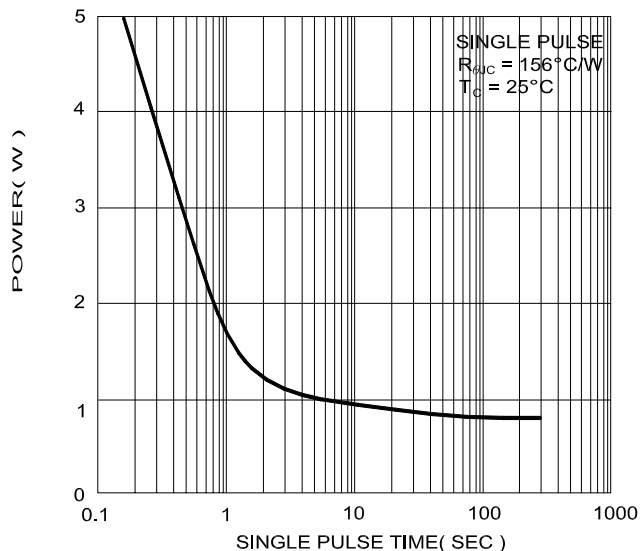
Capacitance Characteristics



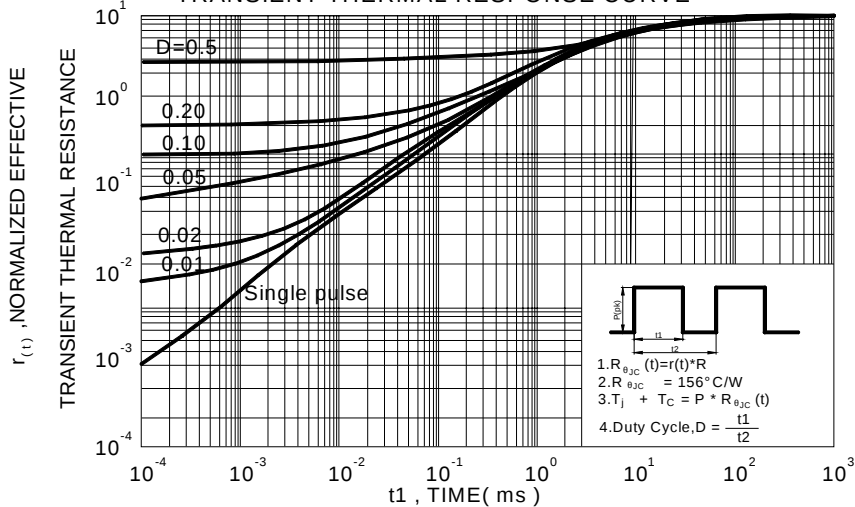
MAXIMUM SAFE OPERATING AREA



SINGLEPULSE MAXIMUM POWER DISSIPATION

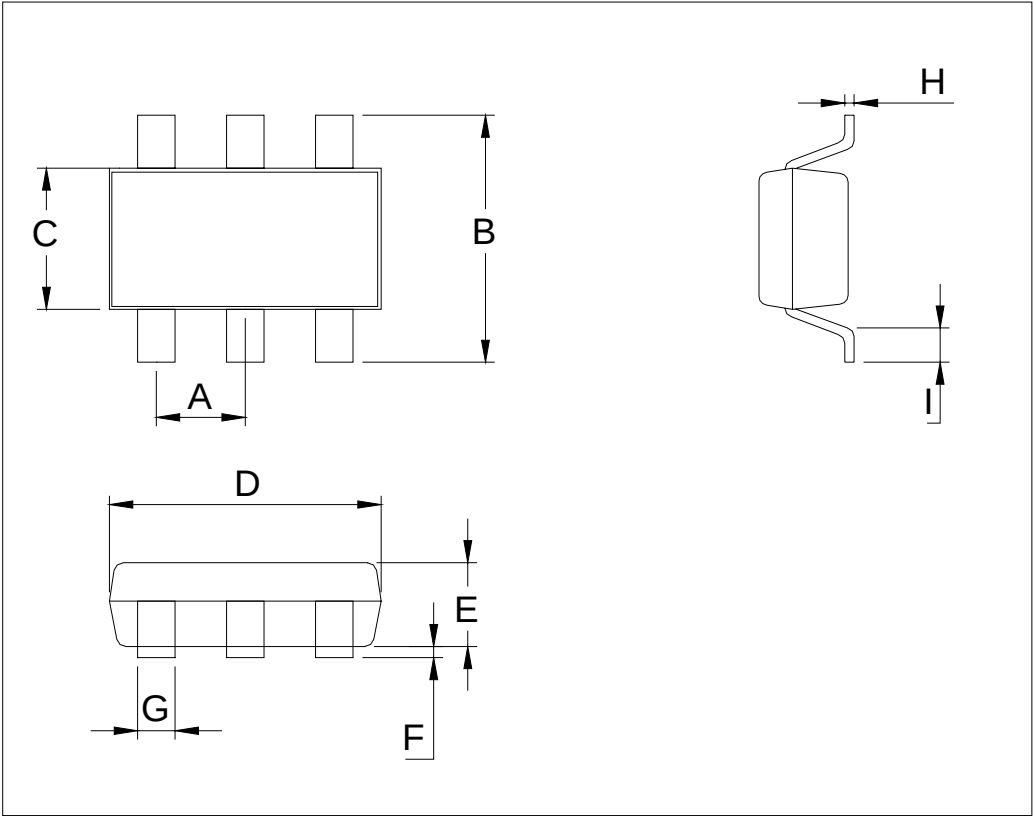


TRANSIENT THERMAL RESPONSE CURVE



TSOP- 6 MECHANICAL DATA

Dimension	mm			Dimension	mm		
	Min.	Typ.	Max.		Min.	Typ.	Max.
A		0.95		H	0.08	0.13	0.2
B	2.5	2.8	3.1	I	0.3		0.6
C	1.5	1.6	1.7	J			
D	2.7	2.9	3.1	K			
E	0.7		1.2	L			
F	0		0.15	M			
G	0.3	0.4	0.5	N			





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331